

DIN 50453-2:2023-08 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

| Inhalt | Seite |
|---|----------|
| Vorwort | 3 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 4 |
| 2 Normative Verweisungen | 4 |
| 3 Begriffe | 4 |
| 4 Kurzbeschreibung des Verfahrens | 4 |
| 5 Geräte..... | 4 |
| 6 Silicium-Substrat | 5 |
| 7 Zusammensetzung der Ätzmischungen | 5 |
| 8 Einflüsse auf das Messergebnis | 5 |
| 8.1 Struktur der Siliciumdioxid-Schicht..... | 5 |
| 8.2 Temperatur | 5 |
| 8.3 Dotierung..... | 5 |
| 9 Probenvorbereitung..... | 5 |
| 10 Durchführung..... | 5 |
| 11 Auswertung..... | 7 |
| 12 Präzision des Verfahrens..... | 7 |
| 13 Prüfbericht | 8 |
| Literaturhinweise | 9 |
| | |
| Bilder | |
| Bild 1 — Prüfaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen | 6 |